

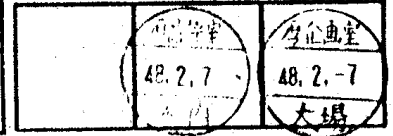
SPECIFICATION TRANSISTORS,
DIODES

NO. 17-2T-1321

2SC1361 · 2SC1362

PAGE: 2/7 / 173

Low Noise 用



DATE: / /

1. 構造 NPN APM型 シリコントランジスタ
2. 用途 高周波増巾, スイッチング, 低雑音増巾
3. 外形 付 函 (JEDEC TO-92 類似)
4. 絶対最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)
- | | 2SC1361 | 2SC1362 |
|--------------|--|--------------|
| コレクタ・ベース間電圧 | $V_{CBO} \quad 25\text{V}$ | 50V |
| コレクタ・エミッタ間電圧 | $V_{CEO} \quad 25\text{V}$ | 50V |
| エミッタ・ベース間電圧 | $V_{EBO} \quad 6\text{V}$ | |
| コレクタ電流 | $I_C \quad 200\text{mA}$ | |
| コレクタ損失 | $P_C \quad 320\text{mW}$ | |
| ジャンクション温度 | $T_j \quad 120^\circ\text{C}$ | |
| 保存温度 | $T_{stg} \quad -30^\circ\text{C} \sim 115^\circ\text{C}$ | |

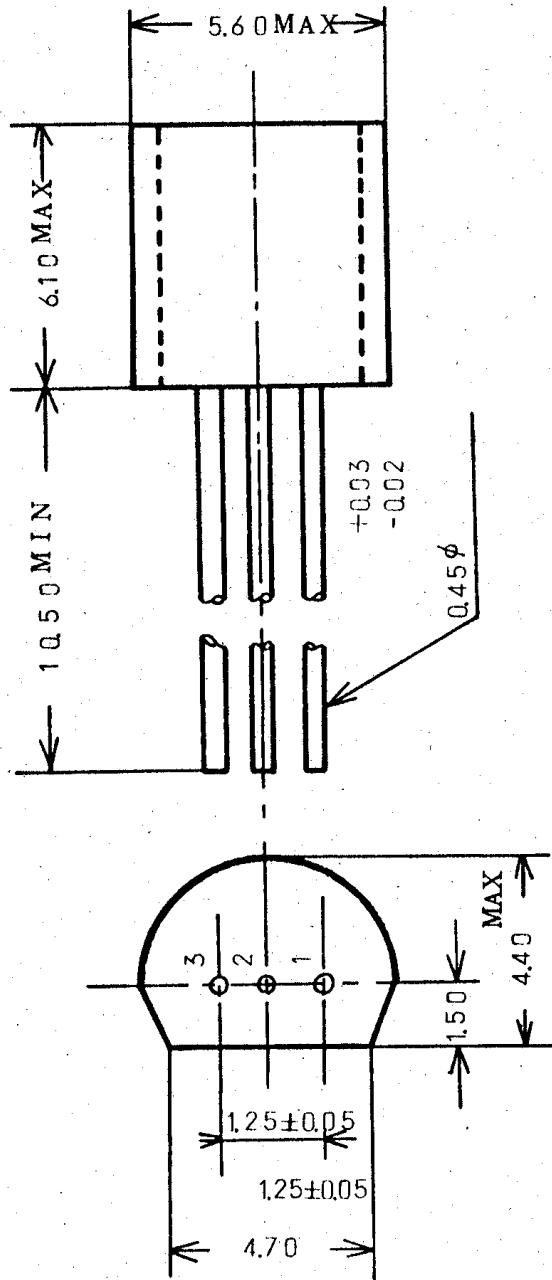
5. 電気的特性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	記号	条件	最小値	標準値	最大値	単位
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	$I_C = 2\text{mA}$ 2SC1361 2SC1362	25 50			V
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 25\text{V}, I_E = 0$			0.2	μA
エミッタ遮断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 6\text{V}, I_C = 0$			1.0	μA
直流電流増巾率	h_{FE}	$I_C = 1\text{mA}, V_{CE} = 3\text{V}$	129		690	
コレクタ・エミッタ 間飽和電圧	$V_{CE}(\text{sat})$	$I_C = 50\text{mA}$		0.10	0.30	V
ベース・エミッタ 間飽和電圧	$V_{BE}(\text{sat})$	$I_B = 10\text{mA}$		0.85	1.20	V
小信号電流増巾率	$ h_{fe} $	$V_{CE} = 6\text{V}, I_E = -2\text{mA}$ $f = 100\text{MHz}$	1.0	3.0		dB
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = 6\text{V}, I_E = 0$ $f = 1\text{MHz}$		4.5	7.0	pF
$C_c \cdot r_{bb'}$	$C_c \cdot r_{bb'}$	$V_{CB} = 6\text{V}, I_E = -2\text{mA}$ $f = 1.5\text{MHz}$		300	600	pS
雑音指数	NF	$V_{CE} = 6\text{V}, I_E = -1\text{mA}$ $R_g = 500\Omega, f = 1\text{kHz}$		4.5	6.0	dB
出力抵抗	R_O	$V_{CE} = 1\text{V}, I_C = 20\text{mA}$ $f = 1\text{kHz}$	350			Ω

6. 規格細分類 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

製 品 名	h_{FE} ($I_C = 1\text{mA}$, $V_{CE} = 3\text{V}$)
2SC1361-6 2SC1362-6	129 ~ 276
2SC1361-7 2SC1362-7	204 ~ 442
2SC1361-8 2SC1362-8	326 ~ 690

2SC1361, 2SC1363 外形図 (JEDEC TO-92 類似)
2SC1362, 2SC1364



単位：mm

電極接続

- 1. エミッタ
- 2. コレクタ
- 3. ベース